



①9 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑩ **DE 197 53 494 A 1**

⑤1 Int. Cl.⁶:
H 01 L 21/20
H 01 L 21/324

②1 Aktenzeichen: 197 53 494.5
②2 Anmeldetag: 2. 12. 97
④3 Offenlegungstag: 1. 10. 98

DE 197 53 494 A 1

③0 Unionspriorität:
9-080939 31. 03. 97 JP
⑦1 Anmelder:
Mitsubishi Denki K.K., Tokio/Tokyo, JP
⑦4 Vertreter:
Prüfer und Kollegen, 81545 München

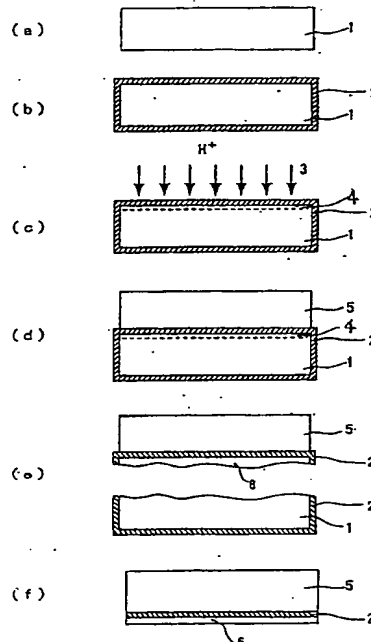
⑦2 Erfinder:
Yamamoto, Hidekazu, Tokio/Tokyo, JP

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑤4 Verfahren zur Herstellung eines Siliziumwafers und dadurch hergestellte Siliziumwafer

⑤7 Ein Siliziumwafer mit einer SOI-Struktur wird ausgebildet, der eine Oberfläche aufweist, die frei von der nachteiligen Wirkung eines chemisch-mechanischen Polierens ist. Anfänglich werden Wasserstoffionen in die Oberfläche eines Siliziumwafers (1) implantiert, um dadurch eine Schicht (4) mit implantiertem Wasserstoff auszubilden. Dann wird der Siliziumwafer so erwärmt, daß die Siliziumoberflächenschicht an der Schicht mit implantiertem Wasserstoff abschält. Der Siliziumwafer wird dann in einer Wasserstoffatmosphäre wärmebehandelt, um dadurch die Oberfläche zu glätten, die durch das Abschälen freigelegt worden ist. Die Wärmebehandlung kann durch eine Plasma-Wärmebehandlung in Wasserstoff oder durch ein schnelles thermisches Glühen ersetzt werden.



DE 197 53 494 A 1



nenimplantation (2×10^{16} bis 1×10^{17} Atome/cm²) wird in einer Oberfläche des Siliziumwafers ausgeführt, um eine Schicht 4 mit implantierten Wasserstoff auszubilden, wie es in Fig. 1(c) gezeigt ist. Ein zweiter Siliziumwafer 5 (als ein Basis-Wafer) oder irgend ein anderes passendes Substrat 5 werden an die Oberfläche des Siliziumwafers gebondet, d. h. mit dieser verbunden, in die die Wasserstoffimplantation ausgeführt worden ist, wie es in Fig. 1(d) gezeigt ist.

Der Siliziumwafer 1 wird dann auf ungefähr 400°C bis ungefähr 600°C erwärmt, so daß seine äußere Schicht an der Schicht 4 mit implantierten Wasserstoff abschält bzw. sich abtrennt, wie es in Fig. 1(e) gezeigt ist, was einen Siliziumwafer 7 mit einer SOI-Struktur ergibt, die ein Substrat 5 und eine dünne Siliziumschicht 6, die daran gebondet ist, aufweist. Die dünne Siliziumschicht 6 wird durch chemisch-mechanisches Polieren geglättet, um ihre Oberflächenunregelmäßigkeiten von ungefähr 20 nm zu entfernen, wie es in Fig. 1(f) gezeigt ist.

Die oben erwähnten Schritte sind dieselben wie diejenigen des Smart-Cut-Verfahrens.

Der Siliziumwafer 7 wird in einer Wasserstoffatmosphäre unter Verwendung eines Glühofens geglättet bzw. wärmebehandelt, wie es in Fig. 2 gezeigt ist. Die Siliziumwafer 7, die zu glühen bzw. mit Wärme zu behandeln sind, werden durch einen Waferhalter 8, der in einem Ofengehäuse 9 plaziert ist, gehalten. Das Ofengehäuse 9 weist einen Wasserstoffeinlaß an seiner Oberseite und einen Auslaß an seinem Boden auf.

Unter Verwendung dieses Glühofens wird der Siliziumwafer 7 in der Stufe aus Fig. 1(e) in einer Wasserstoffatmosphäre bei ungefähr 1050°C bis ungefähr 1350°C für einige 10 Sekunden bis einige 10 Minuten wärmebehandelt. Die Wärmebehandlung ergibt den Siliziumwafer 7 mit einer glatten Oberfläche, wie es in Fig. 1(f) gezeigt ist. Die Glüh-temperatur sollte in dem Bereich von ungefähr 1050°C bis ungefähr 1350°C sein, um eine stabile Bearbeitung, einen verbesserten Durchsatz und eine verbesserte Waferqualität zu erhalten. Eine Wärmebehandlung bei Temperaturen, die niedriger als ungefähr 1050°C liegen, wird eine lange Zeit benötigen, und eine Wärmebehandlung bei Temperaturen, die höher als ungefähr 1350°C sind, wird das Silizium schmelzen.

Ein Glühen bzw. ein Erwärmen in einer Wasserstoffatmosphäre glättet die Oberfläche des Siliziumwafers durch die Neuordnung der Siliziumatome in der Oberfläche, was in Fig. 3 schematisch illustriert ist. Fig. 3(a) ist eine vergrößerte schematische Schnitansicht der Oberfläche des Siliziums vor der Wärmebehandlung. Ein Erwärmen in einer Wasserstoffatmosphäre aktiviert die Oberfläche des Siliziums, wie es in Fig. 3(b) gezeigt ist. Die aktivierten Siliziumatome bewegen sich in der Oberfläche herum, bis sie energetisch stabil werden bzw. in eine energetisch stabile Lage kommen, was in der Oberfläche resultiert, die in Fig. 3(c) gezeigt ist.

Eine Wärmebehandlung nach der Stufe aus Fig. 1(e) ergibt einen Siliziumwafer, der frei von der nachteiligen Wirkung des chemisch-mechanischen Polierens ist.

Alternativ kann der Siliziumwafer in der Stufe aus Fig. 1(e) zuvor einem optionalen chemisch-mechanischen Polieren in einem angemessenen Ausmaß unterliegen. Dieses chemisch-mechanische Polieren vereinfacht und beschleunigt das Glühen in einer Wasserstoffatmosphäre. Der resultierende Siliziumwafer ist frei von der nachteiligen Wirkung des chemisch-mechanischen Polierens.

2. Ausführungsform

Entsprechend dieser Ausführungsform wird ein Siliziumwafer mit SOI-Struktur unter Verwendung einer Schnell-

glühvorrichtung, die in Fig. 4 gezeigt ist, hergestellt. Die Glühvorrichtung besteht aus einer Aufnahme 10 zum Halten des zu glühenden Siliziumwafers 7, einer transparenten Kammer 11 und Infrarot-Heizlampen 12. Die Kammer 11 weist einen Wasserstoffeinlaß an der linken Seite und einen Auslaß an der rechten Seite auf.

Anders als bei dem Stapelbetrieb der ersten Ausführungsform erlaubt das Glühen bei dieser Ausführungsform eine Einzelwafer-Verarbeitung durch schnelles thermisches Glühen, bei der der Siliziumwafer mit Wärmestrahlung für eine kurze Zeit bestrahlt wird. Die Quelle der Wärmestrahlung können Halogenlampen, Bogenlampen oder Xenon-Blitzlampen sein. Dieses Glühen bzw. diese Wärmebehandlung kann bei dem Siliziumwafer 7, der in der ersten Ausführungsform vorbereitet wurde, angewendet werden. Der Vorteil des schnellen Glühens ist eine einfache Prozeßsteuerung.

3. Ausführungsform

Entsprechend dieser Ausführungsform wird ein Siliziumwafer mit einer SOI-Struktur unter Verwendung einer Plasma-Glühvorrichtung hergestellt, wie sie in Fig. 5 gezeigt ist. Die Glühvorrichtung besteht aus einem Paar von Elektroden 13, zwischen denen der Siliziumwafer 7 gehalten wird, einer Kammer 14, einem Hochfrequenzgenerator (Radiofrequenzgenerator) 15 und einem Kondensator 16. Die untere Elektrode wird durch eine Heizeinheit (nicht gezeigt) auf hundertsten von Grad gehalten. Die Kammer 14 weist einen Wasserstoffeinlaß auf der linken Seite und einen Auslaß an der rechten Seite auf. In diesem Fall wird Plasmawasserstoff durch Hochfrequenzleistung erzeugt. Es ist möglich, ein Plasma durch Verwenden von ECR (Electron-Zyklotron Resonance = Elektronen-Cyclotron-Resonanz) oder Verwendung eines Lichtstrahles zu erzeugen. Dieses Glühen kann bei dem Siliziumwafer 7, der in der ersten Ausführungsform vorbereitet wird, angewendet werden.

Anders als bei der Wärmebehandlung in der ersten und der zweiten Ausführungsform, die bei einer hohen Temperatur in Wasserstoff ausgeführt worden ist, wird die Wärmebehandlung bei dieser Ausführungsform in einem Plasma ausgeführt. Der Vorteil der Wärmebehandlung in einem Plasma ist der, daß die Wärmebehandlungstemperatur niedrig ist, wobei sie in einem Bereich von ungefähr Raumtemperatur bis ungefähr 600°C liegt. Eine Wärmebehandlung bei dieser Ausführungsform benötigt eine kürzere Zeit als diejenige bei der ersten Ausführungsform, wodurch die Prozeßsteuerung erleichtert und eine Kontamination reduziert wird.

4. Ausführungsform

Entsprechend dieser Ausführungsform wird ein Siliziumwafer mit einer SOI-Struktur unter Verwendung eines epitaxialen Wachstumssystems hergestellt, wie es in Fig. 6 gezeigt ist. Das epitaxiale Wachstumssystem besteht aus einem Halter 17 zum Halten und Drehen des Siliziumwafers 7 für ein epitaxiales Wachstum, einer Hochfrequenzspule (Radiofrequenzspule) 18 und einer Kammer 19. Die Kammer 19 weist einen Wasserstoffeinlaß in Zentrum und Auslässe an der rechten und linken Seite auf.

Anders als bei der ersten Ausführungsform, bei der ein Abschälen des Wafers durch eine Wärmebehandlung in Wasserstoff gefolgt wird, ist diese Ausführungsform so entworfen, daß das epitaxiale Wachstum des Siliziums auf der abgeschälten Oberfläche ausgeführt wird, die freigelegt worden ist nachdem die dünne Siliziumschicht 6 an der Schicht 4 mit implantiertem Wasserstoff in der Stufe aus Fig. 1(e) abgeschält worden ist. Das epitaxiale Wachstum

FIG. 1

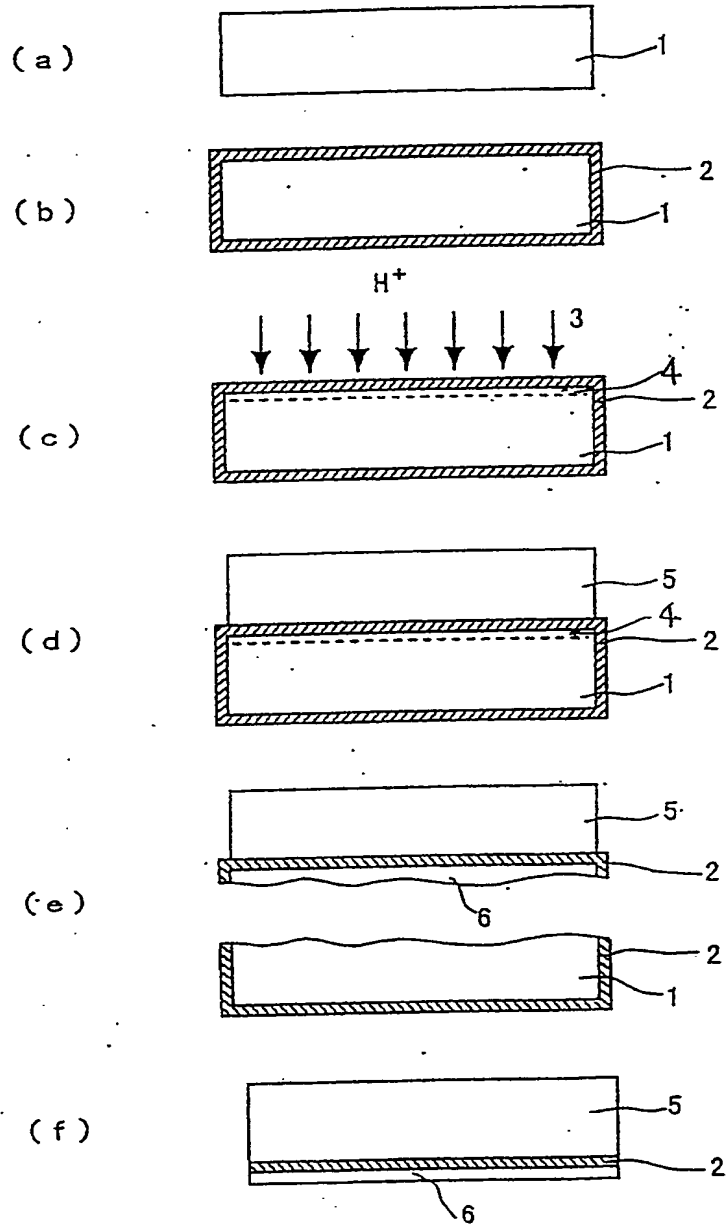


FIG. 3

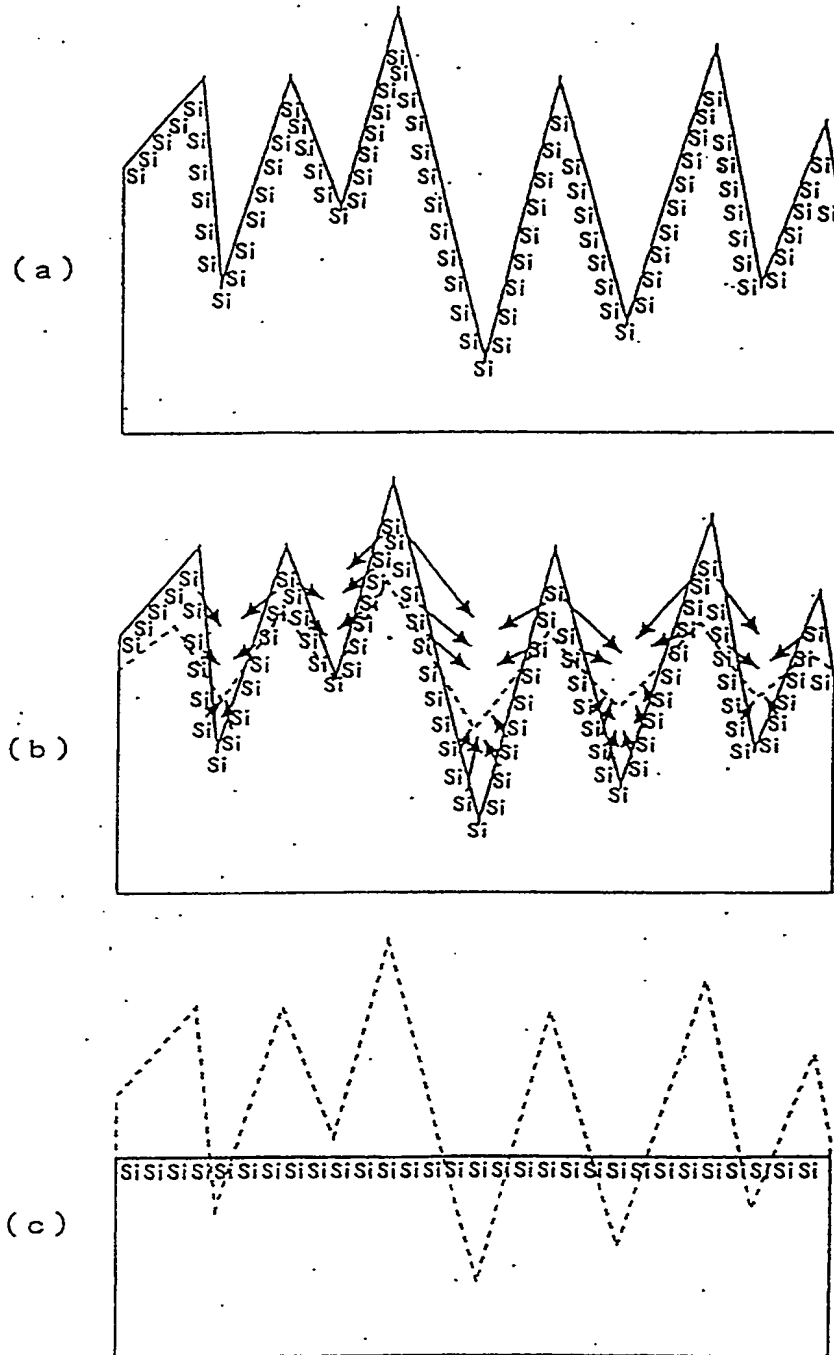


FIG. 6

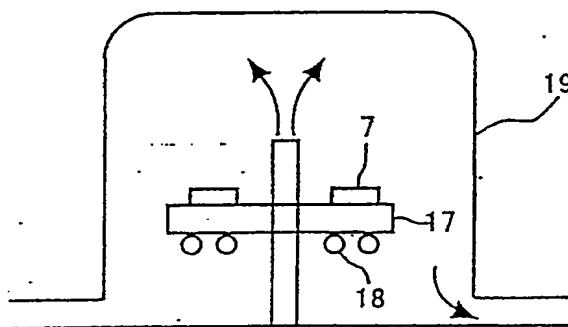


FIG. 7

